```
(Item 3 from file: 351)
1/3/3
DIALOG(R) File 351: Derwent WPI
(c) 2006 Thomson Derwent. All rts. reserv.
008181746
             **Image available**
WPI Acc No: 1990-068747/199010
XRAM Acc No: C90-030060
XRPX Acc No: N90-052658
 Oxide superconductor combining high current density and critical temp. -
 by incorporating e.g. plastic deformation steps to control the
  orientation of the superconducting phases
Patent Assignee: SUMITOMO ELECTRIC IND CO (SUME )
Inventor: HIKATA T; MUKAI H; SATO K; HITOTSUYANAGI H; HOSODA Y; KAWASHIMA M
  ; NAGATA M; OHMATSU K; SHIBUTA N; TAKANO S
Number of Countries: 011 Number of Patents: 008
Patent Family:
Patent No
              Kind
                     Date
                             Applicat No
                                             Kind
                                                    Date
                                                             Week
EP 356969
                   19900307
                             EP 89115862
                                                  19890828
                                                            199010
               Α
                                              Α
AU 8939596
                   19900301
                                                            199018
               Α
JP 3138820
                             JP 89209325
                                                  19890812
               Α
                   19910613
                                              Α
                                                            199130
EP 356969
               В1
                   19941228
                             EP 89115862
                                              Α
                                                  19890828
                                                            199505
DE 68920234
               E
                   19950209
                             DE 620234
                                              Α
                                                  19890828
                                                            199511
                             EP 89115862
                                                  19890828
                                              А
US 5639714
               Α
                   19970617
                             US 89394699
                                              Α
                                                  19890816
                                                            199730
                             US 93128034
                                              Α
                                                  19930927
                             US 95459624
                                              Α
                                                  19950602
               В2
                   19970730
                             JP 89209325
JP 2636049
                                              Α
                                                  19890812
                                                            199735
                             US 89394699
US 6276048
               B1
                   20010821
                                              Α
                                                  19890816
                                                            200150
                             US 93128034
                                                  19930927
                                              Α
                              US 95459624
                                                  19950602
                             US 96747133
                                              А
                                                  19961112
Priority Applications (No Type Date): JP 89164510 A 19890627; JP 88214342 A
  19880829; JP 88334576 A 19881228; JP 8918664 A 19890127; JP 8928117 A
  19890206; JP 8965695 A 19890316; JP 89162442 A 19890624; JP 88233084 A
  19880917; JP 89209325 A 19890812
Patent Details:
Patent No Kind Lan Pg
                         Main IPC
                                      Filing Notes
EP 356969
              A E 19
   Designated States (Regional): CH DE FR GB IT LI NL SE
EP 356969
              B1 E 19 H01L-039/14
   Designated States (Regional): CH DE FR GB IT LI NL SE
                                      Based on patent EP 356969
DE 68920234
                       H01L-039/14
              Ε
                                      Cont of application US 89394699
US 5639714
                    13 H01L-039/24
              Α
                                      Cont of application US 93128034
                                      Previous Publ. patent JP 3138820
JP 2636049
                    12 H01B-013/00
              B2
US 6276048
                       H01L-039/24
                                      Cont of application US 89394699
                                      Cont of application US 93128034
                                      Div ex application US 95459624
                                      Div ex patent US 5639714
```

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-138820

(43)Date of publication of application: 13.06.1991

(51)Int.CI.

H01B 13/00 B21C 1/00 C01G 29/00 // H01B 12/04

(21)Application number: 01-209325

(71)Applicant: SUMITOMO ELECTRIC IND LTD

(22)Date of filing:

12.08.1989

(72)Inventor: HIKATA TAKESHI

SATO KENICHI

MUKAI HIDETO DAIMATSU KAZUYA NAGATA MASAYUKI TAKANO SATORU HOSODA YOSHIHIRO **ICHIYANAGI HAJIME** KAWASHIMA MASANARI SHIBUTA NOBUHIRO

(30)Priority

Priority number: 63214342

Priority date : 29.08.1988 63233084

Priority country: JP

17.09.1988 63334576 28.12.1988 27.01.1989 64 18664

64 28117 06.02.1989 64 65695 16.03.1989 01162442 24.06.1989

JP JP

01164510 27,06,1989

JP

JP

JP

JP

(54) MANUFACTURE OF OXIDE SUPERCONDUCTOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain an oxide superconductor with high critical current density by applying the first plastic processing, the first heat treatment, the second plastic processing, and the second heat treatment to a raw material in sequence.

CONSTITUTION: The first plastic processing is applied to a raw material, the first heat treatment is applied to the material applied with the first plastic processing, and the second plastic processing is applied to the material applied with the first heat treatment, and the second heat treatment is applied to the material applied with the second plastic processing in steps. When the second plastic processing is applied after the first heat treatment is applied, the orientation of the superconductive phases generated by the first heat treatment can be aligned. When the second heat treatment is applied, the bonding between the superconductive phases aligned with orientation can be increased. Thus, an oxide superconductor with high critical current density can be obtained.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the

匈日本国特許庁(JP)

@ 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平3-138820

• 91nt. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)6月13日

13/00 H 01 B 1/00 29/00

Z HCU

7244-5G 6778-4E

ZAA

7158-4G X

審査請求 未請求 請求項の数 41 (全21頁)

60発明の名称

酸化物超電導体の製造方法

顧 平1-209325 创特

包出 頭 平1(1989)8月12日

特許法第30条第1項適用 1988年8月21日、1988 Applied Superconductivity conterenceに発表 図昭63(1988) 8月29日 個日本(JP) 図特願 昭63-214342 優先権主張

外2名

@発 明 者

方 B

大阪府大阪市此花区島屋1丁目1番3号 住友電気工業株 式会社大阪製作所内

何発 明 佐藤

鎌

大阪府大阪市此花区島屋1丁目1番3号 住友電気工業株 式会社大阪製作所内

何発 明 向井 英 仁 考

大阪府大阪市此花区岛屋1丁目1番3号 住友電気工業株

式会社大阪製作所内

勿出 顧 人 住友電気工業株式会社 大阪府大阪市中央区北浜 4丁目 5番33号

29代 理 人 弁理士 深見 久郎

最終質に続く

1. 発明の名称

酸化物超電事件の製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 原料を熱処理することによりBi-P b-Sr-Ca-Cu系数化物超電導体を製造す る方法であって、

前記原料に第1の塑性加工を施し、

前記第1の塑性加工を施した材料に第1の熱処 迎を悔し、

節記第1の無処理を施した材料に節2の製性加 工を施し、

前記窓2の御作加工を施した計劃に第2の熟紙 選を施す各ステップを伺える、酸化物超電導体の 製造方法。

- (2) 前記第1の製性加工のステップが、金 国シースに充塡された原料に対して第1の塑性加 工を施すステップを得える、請求項1記載の酸化 物超電導体の製造方法。
 - (3) 剪記第1の製性加工のステップが、バ

ルクの状態の原料に対して直接に第1の塑性加工 を集すステップを備える、請求項1記載の酸化物 都常導体の製造方法。

(4) 前記Bi-Pb-Sr-Ca-Cu系 酸化物超電導体が、

Bi z. - xPbr Sr z. Ca z. Cuy

(ここで、x, y, z,, z,およびェ。は、

 $0.2 \le z \le 0.8, 1.5 \le z_1, z_2, z_4$

≤3.0.2.5≤y≤4.5を調足する数であ

と酸塩からなる組成を育する、請求項1記載の酸 化物超電導体の製造方法。

(5) 前記Bi-Pb-Sr-Ca-Cu系 酸化物超電導体が、

Bia Pbs Src Cad Cue

化物組電券体の製造方法。

(ここで、a, b, c, dお上びeは、a+b: c:d:e:=1, 7-2, 8:1, 7-2, 5:1. 7~2. 8:3を講足する数である。) と健業からなる組成を有する、薪永項1 記載の機

特閒平3-138820(2)

(6) 原料を熱処理することによりBI-Pb-Sr-Ca-Cu系酸化钠超電導体を製造する方法であって、

前記原料に第1の競性加工を施し、

前記第1の塑性加工を施した材料に780~860℃の選定範囲内で第1の熱処理を施し、

前記第1の熱処理を施した材料に断面減少率が 10%以上の第2の塑性加工を施し、

前記第2の製性加工を施した材料に780~860での湿度範囲内で第2の熱処型を施す各ステップを届える、酸化物超電導体の製造方法。

- (7) 射記第1の塑性加工のステップが、金 ロシースに充棋された原料に対して第1の塑性加工を施すステップを備える、請求項6記載の酸化 物超電導体の製造方法。
- (8) 前記金属シースが最または銀合金からなる、請求項で記載の酸化物超電場体の製造方法。
- (9) 前記塑性加工が、圧延加工、プレス加工または伸線加工である、請求項6に記載の酸化 物経電導体の製造方法。

加工を施すステップを備える、請求項11に記載 の酸化物超電導体の製造方法。

- (13) 前記金属シースが銀または銀合金からなる、請求項12記載の酸化物超鐵導体の製造方法
- (14) 前記提性加工が、圧延加工、プレス 加工または仲線加工である、請求項11に記載の 酸化物超電導体の製造方法。
- (15) 南記BI-Pb-Sr-Ca-Cu系 酸化物超電導体が、

Bi z₁₋ IP b x S r z₂ C a z₃ C u y (ここで、x, y, z₁, z₂ およびz₃ は、 0. 2 ≤ x ≤ 0. 8, 1. 5 ≤ z₁, z₂, z₃ ≤ 3. 0. 2. 5 ≤ y ≤ 4. 5 を隣足する数であ る。)

と酸素からなる組成を有する、請求項 1 1 記載の 酸化物超電導体の製造方法。

(16) Bia Pb。 Src Cad Cu。 (ここで、a、b、c. dおよびeは各元素の組 成比を示す数である。) および融索からなる組成 (10) 前記Bi-Pb-Sr-Ca-Cu 系験化物超電導体が、

Bi2-x Pbx Sr2 Ca2 Cuy

(ここで、x およびy は、0. 2 ≤ x ≤ 0. 8. 2. 5 ≤ y ≤ 4. 5 を調足する数である。) と数素からなる組成を育する、請求項6 記載の数 化物銀電導体の製造方法。

(11) 原料を熱処理することによりBl-Pb-Sr-Ca-Cu 系酸化物紐電導体を製造する方法であって、

前記原料に第1の類性加工を放し、

前記第1の型性加工を厳した材料に780~860での温度範囲内で第1の無処理を施し、

前記第1の熱処理を施した材料に1ton/cm²以上の資理を加える第2の塑性加工を厳し、

前記第2の型性加工を施した材料に780~8 60℃の温度範囲内で第2の熱処理を施す各ステップを備える、酸化物超電導体の製造方法。

(12) 朝記第1の題性加工のステップが、 金属シースに充単された原料に対して第1の競性

を有する超電導体であって、

前記a, b, c, d, およびeが、

 $a+b:c:d:e:-1.7\sim 2.8:1.$

7~2. 5:2. 0~2. 5:3、および

a:b-3~9:1

を講足し、かつ配向した超電器相の粒界部に非超 電器相が分散して存在していることを特徴とする、 超電導体。

(17) 原料を無処理することによりBi-Pb-Sr-Cs-Cu系酸化物超電學体を製造する方法であって、

関記原料として低い臨界温度の超電専相が主に 生成されるように熱処型された粉末を準備し、

前記取料に第1の塑性加工を施し、

前配第1の塑性加工を施した材料に至1の無処理を施し、

前記第1の熱処理を施した材料に第2の型性加工を施し、

即記第2の製性加工を譲した材料に第2の熱処 理を施す各ステップを輸える、酸化物超電媒体の

特開平3-138820 (3)

财选方法。

(18) 前記第1の型性加工のステップが、 金属シースに充填された原料に対して第1の型性 加工を施すステップを備える、請求項17に記載 の酸化物超電媒体の製造方法。

(19) 前記金属シースが、銀または銀合金からなる、請求項18に記載の酸化物超電導体の製造方法。

(20) 原料を熱処理することによりBi-Pb-Sr-Ca-Cu系数化物超電導体を製造する方法であって、

前記原料に第1の塑性加工を施し、

前記第1の塑性加工を施した材料に第1の熱処理を施して高い臨界温度の超電導相を生成させ、

前記第1の無処理を施した材料に第2の塑性加工を施し、

前記第2の型性加工を施した材料に第2の熱処 理を施す各スチップを備える、酸化物超磁導体の 製造方法。

(21) 前記第1の製性加工のステップが、

する方法であって、

前記原料に第1の数性加工を施し、

前記第1の型性加工を施した材料に第1の無処理を施し、

. 前記第1の無処理を施した材料を少なくとも300℃までの温度範囲において100℃/時以上の速度で冷却し、

前記第1の熱処理後冷却した材料に第2の塑性 加工を厳し、

前記第2の塑性加工を施した材料に第2の熱処 銀を施し、

前記第2の熱処型を施した材料を少なくとも300℃までの温度範囲において100℃/時以上の速度で冷却する各ステップを備える、酸化物超電等体の製造方法。

(26) 前記第1の熱処理および第2の熱処理がそれぞれ800~860での温度で熱処理される、請求項25に記載の酸化物超電導体の製造方法。

(27) 前記第1の無処理および第2の無処

金属シースに充填された原料に対して第1の塑性 加工を施すステップを輸える、請求項20に記載 の酸化物超電場体の製造方法。

(22) 前記BiーPbーSrーCaーCu 系数化物超電導体が、

Bia Pbb Src Cad Cue

(ここで、a, b, c, dおよびeは、a+b:
c:d:e:=1, 7~2, 8:1, 7~2, 5:
1, 7~2, 8:3を満足する数である。)
と酸素からなる組成を育する、請求項20記載の
酸化物組電導体の製造方法。

(23) 前記金属シースが、酸化物超電再体と反応せず、かつ低比低抗の金属または合金からなる、請求項21に記載の酸化物超電等体の製造方法。

(24) 可記金属シースが、銀または銀合金である、請求項21に記載の酸化物超電導体の製造方法。

(25) 原料を熱処理することによりBi-Pb-Sr-Ca-Cu系酸化物超電導体を製造

理後の冷却が、それぞれ500℃程度までの温度 範囲で150℃/時以上の速度で冷却される、請 求項25に記載の歴化物超氧単体の製造方法。

(28) 前記第1の熱処理および第2の熱処 理能の冷却が、それぞれ強制的に行なわれる、請求項25に記載の酸化物超電導体の製造方法。

(29) 前記Bi-Pb-Sr-Ca-Cu 系酸化物超電導体がアンチモンを含む、請求項2 5に記載の酸化物超電導体の製造方法。

(30) 前記第1の型性加工のステップが、 金属シースに充填された原料に対して第1の型性 加工を施すステップを備える、請求項25に記載 の彼化物函電等体の製造方法。

(31) 原料を熱処理することにより、Bi -Pb-Sr-Ca-Cu系酸化物超電導体を製造する方法であって、

前記原料として、減圧雰囲気下で焼結した粉末 を準備し、

前記原料に第1の塑性加工を築し、

前記第1の塑性加工を施した材料に第1の熱処

特開平3-138820 (4)

型を施し、

前記第1の無処理を施した材料に第2の製性加工を組し、

前記第2の型性加工を施した材料に第2の熱処理を施す各ステップを超える、酸化物超電導体の 製造方法。

- (32) 前記第1の塑性加工のステップが、 企区シースに充填された原料に対して第1の塑性 加工を施すステップを含える、請求項31に記載 の酸化物摂電等体の製造方法。
- (33) 前記Bl-Pb-Sr-Ca-Cu 系酸化物超電写体が、

Big Pbo Src Cad Cue

(ここで、a, b, c, dおよびeは、a+b:
c:d:e:=1.7~2.8:1.7~2.5:
1.7~2.8:3を満足する数である。)
と酸紫からなる組成を有する、請求項31に記載
の酸化物超電導体の製造方法。

(34) 前記金属シースが酸化物超電導体と 反応せず、かつ低比低抗の金属または合金からな

臨界温度の超電導相を主に生成させた粉末を準飾 1...

前記原料を金銭シースに充填し、

前記金属シースに充戦した原料に第1の型性加工を縮し、

前記第1の型性加工を総した材料に780~8 60℃の温度範囲内で第1の熱処理を施して高い 臨界温度の超電専相を生成させ、

前記第1の熱処理を施した材料を少なくとも3 00でまでの温度範囲において100℃/時以上 の速度で冷却し、

前記第1の無処理後冷却した材料に1 ton/cm²以上の資金を加える第2の要性加工を施し、 前記第2の要性加工を施した材料に第2の熱処 理を施し、

前記算2の熱処型を施した材料を少なくとも300℃までの温度範囲において100℃/時以上の速度で冷却する各ステップを確える、酸化物超磁導体の製造方法。

(40) 原料を熱処理することによりBi-

る、請求項32に配数の酸化物超式導体の製造方 *!-

- (35) 前記金属シースが、叙または銀合金からなる、請求項32に記載の酸化物超電導体の製造方法。
- (36) 前記減圧雰囲気がおよそ1Torr に減圧した大気の雰囲気である、請求項31に記 載の酸化物組織要体の製造方法。
- (37) 前記銭圧雰囲気下の焼結温度が72 0~850でである、緯水項31に記載の酸化物 超電器体の製造方法。
- (38) 前記減圧雰囲気下での焼結に先立って、減圧雰囲気下での焼結固度より低い過度で焼結され、次いで減圧雰囲気下での温度より高い温度で焼結される、前水項31に記載の酸化物超電 単体の製造方法。
- (39) 原料を熱処理することにより B 1 P b S r C a C u 系蔵化物超電導体を製造する方法であって、

前紀原料として、紋圧雰囲気下で焼結して低い

Pb-Sr-Cz-Cu系酸化物超階導体を製造する方法であって、

前記版料を前記酸化物超電導体と反応したくい 金属材料からなるシースに宏収し、前記金属シースに宏収された原料に前記熱処理を施す各ステップを備える、酸化物超電導体の製造方法。

(41) 前記金属シースが築または製合金からなる、前求項40記載の酸化物超電導体の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

この発明は、BI-Pb-Sr-Ca-Cu系 酸化物超電母体の製造方法に関するものであり、 特に高い監界電流密度を得るための改良に関する ものである。

[従来の技術]

特定の物質は、超電部現象下で反磁性を示し、 内部に有限な定常電流が流れているにもかかわら 才能位差が現われなくなる。

この超電導現象の応用分野は、MHD発電、電

力送電、電力貯蔵等の電力分野、あるいは、磁気 浮上列車、電磁気性遮船前等の動力分野、さらに、 磁場、高周波、放射線等の超高感度センサとして、 またNMR、π中間子治療、高エネルギ物理実験 装置の分野等、極めて広範な分野にわたっており、 さらに、ジョセフソン索子に代表されるエレクト ロニクスの分野でも、単に消費電力の低減のみな らず、動作の極めて高速な衆子を実現し得る技術 として期待されている。

ところで、かつて超電導は、超低温下においてのみ観測される現象であった。すなわち、従来の超電導材料として最も高い超電導臨界温度Tcを有するといわれていたNb。Geにおいても23.2 Kという極めて低い磁界温度であって、このような温度が長期間にわたって超電導電界温度の限以とされていた。

それゆえ、従来は、超電専現象を実現するために沸点が4.2Kの液体へリウムを用いて超電専材料を上述したような臨界温度以下まで冷却していた。しかしながら、液体へリウムの使用は、液

* を超える電流密度が得られなければならない。 しかも、超電源体が長尺化されたとき、このような電流体が長尺化されたとき、方向にわたな電流体が長尺の超電液体の長さ方向にわたり、研究を関係を用いたりすることはが、100~2である。しかの電流を高においでである。しかしながのようなBI系の電流ででは、いて200A/cm²のレベルである。しかしながのようなBI系の電流ではせいがしながのといるが、この10倍以上の電流密度があるととがあるというなる。 要があるととないますなる。必要があるととないますないで、変更があるととないである。 で、その自己において、変更があるととないますないで、この10倍以上の電流密度があるととない。この10倍以上の電流密度がある。

この発明の目的は、液体弦素温度をはるか越え る100K以上で超電導性を示し、しかも大きな 電液密度を示す酸化物超電導体の製造方法を提供 することにある。

[課題を解決するための手段およびその作用効果] この発明に従う酸化物超電導体の製造方法は、 原料を熱処理することによりBi-Pb-Sr化数量を含めた冷却数量による技術的負担および コスト的負担が極めて大きく、超電導技術の実用。 化への妨げとなっていた。

ところで、近年に至って複合酸化物焼結体が高い電界温度で超電原体となり得ることが報告され、非低型超電原体による超電原技術の実用化がにわかに促進されようとしている。既に報告されているY-Ba-Cu-O系では90Kで、Bi-Sr-Ca-Cu-O系では110Kで、それぞれ超電構現象を示すことがわかっている

[免明が解抉しようとする無鑑]

液体窒素は、入手が比較的容易で関係であるので、液体窒素温度で動作する超電感材料の発見を もって超電療技術の実用化が大きく進歩したこと は事実である。

しかしながら、臨界温度だけではなく、実際に使用する場合、たとえば超電導マグネット、デバイス用配線、電力ケーブルなどは、電流密度が重大な関心事であり、少なくとも1000A/cm

Ca-Cu系酸化物超電導体を製造する方法であって、原料に第1の塑性加工を施し、第1の塑性 加工を施した材料に第1の熱処理を施し、第1の 熱処理を施した材料に第2の塑性加工を施し、第 2の塑性加工を施した材料に第2の熱処理を施す 各ステップを備えている。

第1図は、この発明の製造方法を示すフローチャート図である。第1図に示すように、この発明に従えば、原料に第1の製性加工、第1の熱処理を順次施こす。

この発明に従い、第1の熱処理を厳した後、第 2の物性加工を施すことにより、第1の熱処理で 生成した超電専相の方位を構えることができる。 さらに第2の熱処理をすることにより、この方位 の積った超電専相の間の結合を強くすることがで き、これによって高い臨界電域密度を有する酸化 物超域複体を得ることができる。

この免明によれば、原料は金属シースに充填された状態で第1の塑性加工、第1の熱処理、第2

特閒平3-138820 (6)

の製性加工および第2の熱処理が総されることが 好ましい。しかしながら、原料を必ずしも金属シ ースに充填される必要はなく、パルク状態の粉末 圧縮成形物に対して道接に第1の塑性加工を施し でもよい。また原料は金属プレートにはさまれた サンドイッチ状のものでもよい。この発明によれ ば、原料は金属粉末や、あるいは他の酸化物粉末 と混合されていてもよい。

また、この免明で製造されるBl~Pb-Sr-Ca-Cu系数化物超電導体の組成としては、

Bi z_{1-xPbx Srz₂ Caz₄ Cuy}

(ここで、x, y, z₁, z₂ およびz₃ は、 0. 2≤x≤0, 8, 1, 5≤z₁, z₂, z₃ ≤3. 0. 2. 5≤y≤4. 5を満足する数である。)

と酸柔からなる組成を挙げることができる。

さらに、好ましくは、

Bia Pbo Src Cad Cua

(:: c: d: e: -1. 7~2. 8:1. 7~2. 5:

この発明に従う第1の実施態様(エンボディメント)においては、第2の要性加工は、断面減少率が10%以上の塑性加工であり、第1の熱処理および第2の熱処理が780~860での温度範囲内で行なわれる。

すなわち、この第1の実施態様は、原料に第1の塑性加工を施し、第1の要性加工を施した材料に780~860での温度範囲内で第1の熱処理を施し、第1の熱処理を施した材料に断面減少率が10%以上の第2の塑性加工を施し、第2の塑性加工を施した材料に780~860での温度範囲内で第2の熱処理を施す各ステップを確えている。

この第1の実施無疑においては、第2の塑性加工の斯面減少率は好ましくは20%以上である。

この第1の実施態様で製造される酸化物超電事体の組成として、たとえば、

Bi2-x Pbx Sr2 Ca2 Cuy

1. 7~2. 8:3を試足する数である。) と酸素からなる組成を有する。

この発明において原料には、各単体あるいは各元素を含む化合物を所定の組成比となるように混合した物末のみならず、この混合した物末を挽結し、これを粉砕したものも含まれる。

したがって、各単体および各元素のうち少なくとも1つを含む化合物から選択した原料、あるいは当該元素を同時に含む組成の粉末から作られたもののいずれをも使用することができる。また、それらの粉末は、酸化物、炭酸塩、硫酸塩、硝酸塩または碳酸塩等が用いられ、それらの配合物も使用できる。また、粒度は、数μmのものから1μm、またはそれ以下のものでもよい。

金属シースとしては、酸素の透過や加工性の面において観および銀合企が好ましい。しかしながら、金属シースを用いない場合でも、あるいは異なる種類の金属シースを用いた場合でも、この発明の作用効果は有効に発揮される。

この発明における第1の数性加工および第2の

(ここで、xおよびyは、0.2≤x≤0.8, 2.5≤y≤4.5を満足する数である。) と酸素からなる組成のものを挙げることができる。 好ましい値としては、xは0.4近筋、yは3近 物である。熱処理過度は雰囲気の酸素過度に依存 するが、適常の大気圧では840で近傍が有利である。

この第1の実施想機によれば、10%以上の断面減少率の加工を第1の熱処理と第2の熱処理の間に加えることにより、超電導相の概密度を上昇させ、配向性を改善させている。この結果、電流密度の大幅な向上が達成される。

この発明に従う第2の実施無限によれば、第2の製作加工において1 ton/cm²以上の荷型を加える気性加工を行ない、第1の無処理および第2の無処理を780~860℃の組度範囲内で行なう。

すなわち、この第2の実施認様は、原料に第1の塑性加工を施し、第1の塑性加工を施した材料に780~860での温度範囲内で第1の熱処理

特別平3-138820(ア)

を施し、第1の熱処理を施した材料に1tan/cm²以上の背近を加える第2の塑性加工を施し、第2の塑性加工を施した材料に780~860での温度範囲内で第2の熱処理を施す各ステップを 値えている。

この第2の実施整様では、第2の類性加工で1 ton/cm²以上の荷瓜を加える加工を施しているため、超電等相の機密度が上昇し、配向性が改善され、さらにグレイン粒界の密着度が向上して、電波密度の大幅な向上が可能となる。

この第2の実施態様より製造される酸化物超電 専体としては、たとえば、

Bi z₁₋₁Pbx Sr z₂ Ca z₃ Cuy

(ここで、x, y, z₁, z₂ およびz₃ は、 0, 2≤x≤0, 8, 1, 5≤z₁, z₂, z₃ ≤3, 0, 2, 5≤y≤4, 5を演足する数であ る。)

と飲業からなる組成を挙げることができる。好ま しい値としては、x は 0 、 4 近傍、y は 3 近傍、x 、 は 1 、 9 近傍、x 、 は 2 近傍、x 、 は 2 . 3

この発明に従う第3の実施態様では、原料として、低い磨界温度の超電専相が主に生成されるように熱処理された粉末を準備する。すなわち、この第3の実施態様では、原料として低い塵界温度の超電事相が主に生成されるように熱処理された粉末を準備し、この原料に第1の製性加工、第2の熱処理、第2の熱処理、第2の熱処理を施す。

この第3の実施整様において製造される組成としては、

Bia Pbo Src Cad Cue

近伤である。また熱処理の温度は雰囲気の酸素設 度に依存するが、通常の大気圧では、840で近 傍が有利である。

この免明により製造された酸化物超電導体をSEMおよびEDXにより観察したところ、配向した超電導相の位界部に非超電導相が分散して存在していることが認められた。したがって、高い臨 外電流密度を示す超電導体は、

Big Pbb Src Cad Cue

(ここで、a, b, c, dおよびeは、a+b:
c:d:e:=1.7~2.8:1.7~2.5:
2.0~2.5:3、およびa:b=3~9:1
を請足する数である。)

と酸素からなる組成を有し、かつ配向した超電専 相の複界部に非超電導相が分散して存在している ものであった。

組成比を示す数値の好ましい値としては、aは 1. 8近妨、bは0. 4近伤、cは2近伤、dは 2. 3近份である。

このような超電導体は、たとえば、上記の組成

この第3の実施想様においては、原料が金属シースに充填されることが好ましい。

この第3の変総態はおいては、原料は110 Kの職界温度を持ち符る組成を有しているにもかかわらず、80 Kの歴界温度を持つ超電路相が主に生成されるように無処理される。たとえば、市 版のBi₂〇。、PbO、SrCO。、CaCO。、CaCO。、CaO(いずれも核皮99.9~99.99 %)初末であって独立1μm程度の粉末に対して、仮焼および焼詰の無処理を範して、超地等な末を作型する場合、仮焼には760~840℃で6~24時間、旋結には800~870℃で6~50時間の熱処理条件が用いられる。ただし、これらの熱処理条件は、用いる粉末の軽額や粒度によって異なる。

特閒平3-138820 (8)

このような粉末を金属シース、好ましくは思または銀合金製の金属シースに光崩し、塑性加工する。型性加工は、冷園、温間、熱園のいずれの湿度範囲で実施してもよく、また、用いる塑性加工方法としては、従来周知の塑性加工方法、すなち、伸棘、スウェージ、ロール圧延、プレス加工などがある。

この第3の災施競技において、原料を、80Kの応界温度を持つ超電導制が主に生成されるように熱処理された粉末とする理由は、次のとおりである。

すなわち、加工後または加工途中における組織 等相の焼結時の成長過程について注目すると、8 0 Kの低温相を成長させることにより、加工され た長手方向に110 Kの高温相が成長し、全体と して臨界温度が100 Kを越えるのみならず、臨 界電波密度を向上させることを見出したためであ る。たとえば、実験によれば、臨界温度が103 ~106 Kの値を持ち、かつ臨界電流密度(77.3 Kにおける)が9000A/cm² 以上の高い

思想はこの発明に挙ずるものである。したがって、この発明の範囲から単に逃れるだけの目的を持って、上述したように、第2の熱処理により高い臨界型度を有する相を生成させ、その後に包性加工を行ない、第3の熱処理を行なったとしても、この発明の範囲内に属するものと解釈されなければならない。

この第4の実施委様においては、第1の熱処理により高型相を生成させるが、この場合密度を可能な疑り高めておくことが望ましい。包性な近工をしては、押出し、スウェージ、総政終、改成、仲稼での方法によるが、好ましくは最終での高の大力に対してある。このとがある。とは指っている。このとがある。したがって、このとがある。とは指っては、高型相の方のとない場合がある。したがって、このとがある。とは指っては、高型相の方のには指っては、高型性加工を進すことにより、方位、特に電波の流れやすいュート面を加工の方のに対して重なのには、

性館を持つ超電導体を得ることができることがわ かった。

この発明に従う第4の実施態様では、第1の無 処理を施すことにより高い臨界温度の超電導和、 すなわち110Kの臨界温度を示す相を生成させる。

このように第1の熱処型で110 K 相を生成させれば、次の第2の製性加工により、この生成した110 K 相の方位を協え、さらに第2の熱処型により、方位の揃った110 K 相関の結合を強めることができる。この結果高い監異電波密度を有する酸化物が無体を得ることができる。

上述のような現象は、本発明者等が実験的に確認したもので、第2の熱処理により高温相を生成させても、高い電流密度は得られない。しかしながら、この場合、第2の熱処理により、高い臨界温度を持つ相を生成させ、その後に塑性加工を行ない、第3の熱処理によって結合を強くすることが考えられる。このような方法は、いたずらに工程を複雑にする欠点が存在し好ましくないものの、

である。しかしながら、このように型性加工を施 した段階では、未だ結晶粒の結合が弱く、さらに 第2の熱処理を施すことにより、結晶粒の結合を 強弱なものにすることができる。

この危引に従う第5の実施無様では、第1の熱処理および第2の熱処理を施した材料を冷却する際、少なくとも300でまでの温度範囲において100で/時以上の速度で冷却する。この第5の実施競技においては、第1の無処理および第2の無処理がそれぞれ800~860での温度で無処理されることが好ましい。

また第1の熱処理および第2の熱処理後の冷却 速度は、500で程度までの温度範囲で150で /時以上の速度で冷却されることが特に好ましい。

たとえば、長尺の線材の形状をなす超電導体を 熱処理する場合、炉の中に前置して熱処理するこ とが多いが、この場合には、ファンを用いたり、 雰囲気を入替えたりすることによって、冷却を強 調的に行ない、冷却速度を上述の値になるように 制御することが好ましい。

特別平3~138820 (9)

また、紐電導体の組成に関して、ピスマスおよび動の一部をアンチモンで製換したものであってもよい。

特に、(Bi, Pb, Sb) a Srb Cac Cudの組成において、a=1.7~2.8,b=1.7~2.5,c=1.7~2.8,d=3が好ましい。さらにBiが1.8近傍、Pbが0.4近傍、Srが2近傍、Caが2.2近傍がそれぞれ好ましい。また、Sbを添加するときは、Biの1.8に対して、0.02~0.2の範囲とすることが、電流密度の向上の点から好ましい。

超電導体を長尺の線材とするときは、たとえば 金属シースに被置された形状とされる。

この第5の実施感様において、熱処理後の冷却 速度を、少なくとも300でまでの温度範囲で、 100で/時以上と規定した理由は、熱処理後の 冷却速度がこれらの値より小さいと、臨界電流密 度が低下するからである。この理由については、 完全に判明はしていないが、ゆっくりと冷却され ていることにより、異相の生成が進み、並昇など

結された酸化物超電感体は、均一な結晶粒を呈し、かつ不純物をほとんど含まない。また、このような酸化物超電導体は、後工程である熱処理により均一な結晶粒を生じさせる。

上述したように、この発明においては原料を金属シースに完異し、第1の塑性加工、第1の熱処理を施すことが好ましい。このような金属シースは、Pbを含んだピスマス系の酸化物超電導体の単一相化を図る上で重要である。このように金属シースが単一相化を図る上において有用である場かしていは、無処理の際に生じるPbの蒸焼を防止していることによるものと考えられる。このような金属シースとしては、酸化物超電導体と反応しにく、ピスマスとしては、酸化物超電導体の場合には製または製合金からなる金属パイプが好ましい。

このように原料を企成シース内に光頃して第1の現性加工、第1の熱処理、第2の想性加工および第2の熱処理を行なうことにより、中一相化さ

にこのような異相が多く存在することになり、 そのような理由から、 臨界地流密度を下げるものと考えられる。

特に、上述のような異相の生成は、500で以上で顕著であり、したがって、無処理温度から500で程度までの高温範囲においては、速く冷却することが性能を上げる点から好ましい。

この発明に従う第6の実施処様では、原料として終圧雰囲気下で焼結した粉末を用いている。

この第6の実施態様では、釘ましくは酸化物超 電導体として上述したような2223組成を基本 とするピスマス系酸化物超電導体が選択される。

減圧舒阻気としては、1 Torr前後の大気が 用いられ、かつ減圧雰囲気での焼結は、720~ 850℃の温度で実施されることが好ましい。

上述した線圧雰囲気での焼結に先立って、線圧 雰囲気での焼結型皮より低い温度で焼結され、次 いで減圧雰囲気での焼結より高い温度で焼結され たものを用いることが好ましい。

この第6の実施態様に従って、試圧雰囲気で焼

れたBI-Pb-Sr-Ca-Cu系酸化物超電 専体を観遊することができる。このため、液体型 業で冷却した場合の冷却温度との温度ギャップを 大きくすることができ、高い臨界電流密度を示す 酸化物超電導体を得ることができる。

[実施例]

北海州I

以下、この発明に従う第1の実施競技の実施例 について説明する。

市阪のBiz0。粉末、PbO粉末、SrCO。粉末、CaCO。粉末、およびCuO粉末を、1.6,0.4。2,2.3の網合で混合し、粉砕起合を経て、800℃×8時間の仮焼、840℃×16時間の熱処理後、内径6mm、外径8mmの銀パイプに充塡して、直径1mmまで伸線した。この線材をテープ状に加工し、840℃×120時間の熱処理を火気中で施した。

その後、表1に示すような斯面減少率の加工度で、減面加工を行ない、その後に840で×40時間の熱処理を施した。

特閒平3-138820 (10)

得られた酸化物超電導体について臨界温度および電波密度を測定し表1に併せて示した。

(以下余白)

表1から明らかなように、10%以上、好ましくは20%以上の断面減少串で加工を加えることにより、級密度の向上、紀向性の向上によると考えられる地流密度の向上が得られ、超越導体の特

实施例口

性向上に有用であることが明らかである。

以下、この発明に従う第2の実施療様の実施例 について説明する。

市販のBizOa粉末、PbO粉末、SrCO) 粉末、CaCO。粉末、およびCuO粉末を、 Bi:Pb:Sr:Ca:Cuを、1.8.0.4.2.2.3。3の割合で混合し、粉砕混合を 経て800で8時間の仮焼、840で16時間の 熱処理後、内径6mm、外径8mmの銀パイプに 充塡して、直径1mmまで仲稼した。この線材を テープ状に加工し、840で×120時間の無処 型を大気中で座した。

次に要2で示すような荷重をかけて第2の型性 加工を施した後、840℃×40時間の第2の熱 処理を施した。 得られた酸化物超電導体について臨界温度および電流密度を測定し表2に併せて示した。

(以下余白)

表2から明らかなように、Iton/cm²以 上、好ましくは2 ton/cm²以上の荷重を加 えることにより、級密度の向上、配向性の向上、 拉界での拉同士の密着度の向上によると考えられ る電流密度の向上が得られ、超電器体の特性向上 に有用であることが明らかである。

空性侧面

以下、第2の実施態様に従い得られた超電導体 の例について説明する。

実施例皿-1

Bi: Pb: Sr: Ca: Cu = 1, 8:0. 4:2:2:3の割合となるように、それぞれの 飲化物を混合し、この混合粉末を800℃で2回、 860℃で1回熱処理した後粉砕した。この粉末 を、外径12mm、内径8mmのAgパイプ中に 充収し、これをスエージ加工および引抜き加工に より、直径2mmのワイヤにした。次に、このワ イヤを厚みり、5mmのテープ状に加工し、84 Oでで100時間の熱処理を行なった後、10t on/cm~ の圧力でプレスし、さらに840℃

Έ

v

5 0 0 0 0

超短短短 m

趋度

四界

(ton/cm²

睴

Œ

0

0

1 1

2 3 S læ. 8 8

4 4

00

2 4 0 0

0

0 1 0 5

m m m 00

0 4 4

0

S 0

0

で50時間の熱処理を行なった。

得られた超電導ワイヤについて、臨界電流密度 (】c)を測定したところ、77.3kで、12 000A/cm2 であった。

4 0 9

実施例Ⅱ-2

一方、Bi:Pb:Sr:Ca:Cu=1.6: 0.4:2.0:1.8:3の割合となるように 混合した酸化物粉末を用い、上記の実施例皿-1 と同様の方法で超電導ワイヤを作製した。この実 施側ロー2の超電導ワイヤのJcを測定したとこ 34000A/cm2 であった。

上記実施例車-1および車-2の超電導ワイヤ について、SEMおよびEDXにより結晶状態を 観察した。第2回は、この観察の結果、実施例皿 - 1の組織導りイヤの結晶状態を模式的に示す図 である。また、第3回は実施例皿-2の組織退体 ワイヤの特品状態を示す模式図である。第2図か ら明らかなように、実施例皿-1の超電導体では、 非超電學相1が超電學相2中において、結晶の記 向方向、すなわち&輪およびb輪に沿うようにし

て薄い層状態で混入していることがわかった。こ れに対し、第3図に示すように、実施側面-2の 超電導体では、非超電導相1が超電導相2の配向 を乱しており、実施例皿-1の構造に比べると、 塩流がスムーズに流れない構造となっていた。

突施例IV

以下、この発明に従う第3の実施態様の実施例 について巡明する。

市販の平均粒径約1μmのBigO」、PbO、 SrCO,、CaCO,、CuOの各粉束 (純度 99, 9~99, 99%) & 1, 8:0, 4: 2:2. 5:3の割合で混合し、仮焼および焼結 下、仮境は800℃の退度で、以下の表3の「粉 末作製時」における「仮焼時間」で示した時間行 ない、他方、焼結は、860℃の温度で、同義の 「粉末作製時」における「焼結時間」に示した時 同行なった。このようにして、80K相を主体と するもの (実施例Ⅳ-1~4)、および11 D K 相を主体とするもの(比較例Ⅳ-1およびⅣ-2) を作数した。なお、これらの相の同定は、X額回

特間平3-138820 (12)

析により可能で、たとえば、C u-K α を用いた回折パターンでは、8 0 K 相は5 . 7 $^{\circ}$ (2 $\theta)$ 近傍に、1 1 0 K 相は4 . 7 $^{\circ}$ (2 $\theta)$ 近傍に、それぞれ(0 0 2) にピークが観察される。

(以下余白)

-	٤	(A/cm²]	10200	8500	10400	0086	2140	\$270
	7.0	[K]	108	108	104	101	104	105
	数時	统格	20	∞	71	œ	200	007
#3 E	粉末作製時	负格	8	1.8	20	24	20	20
	l	5 H ₹ ± ±	BOXE	•	k	"	B) 10 11	Ł
		, o z	IV- 1	IV- 2	IV- 3	IV - 4	I -VI	IV- 2
			棌	選	E		¥	* *

上述のそれぞれの旋結体を粉砕して得られた粉末を、外径6mm、内径4mmの銀製のシースに充棋し、スエージ、仲線により、直径0.64mmの紫線とした。

この素線を、近延により、厚み 0. 25 mmの テープ状線材とし、840~845でで100時間の焼結を行ない、その後、厚み 0. 12 mmに まで冷間圧延を行ない、さらに840~845で で50時間の焼結を行なった。

このようにして得られた試料の臨界程度Tc (K)および77、3Kにおける臨界電波密度Jc (A/cm²)を評価したところ、裏3に示すとおりであった。

災進例V

以下、この発明に従う第4の実施思様の実施例 について説明する。

Bi: 0;、PbO、SrCO;、CaCO;、CuOを用いて、Bi: Pb: Sr: Ca: Cu=1.8:0.4:2:2.2:3の組成比の粉末を準備した。

この粉末を、内径4mm、外径6mmの銀パイプに充填した後、まず、これを直径1.6mmにまで伸載し、その後、0.2mmの厚みになるまで冷間圧延を施し、第1回目の熱処理を表4に示す各条件で行なった。

その後、各試料V-1~8について、0.14 ~0.17mmの序みになるまで冷間圧延し、第 2回目の熱処理として、845℃で50時間の条件で熱処理を施した。

(以下杂白)

特閒平3-138820 (13)

このようにして得られた各試料の特性、特に被体質素投資下での距界電池密度が、同じく炎4に示されている。第1回目の熱処理が高温和を生成させる条件、すなわち「845℃×20時間」以上の条件が与えられた実証例V-5~8の試料では、高い臨界電流密度が得られている。

灾旅例 Ⅵ ˙

以下、この発明に従う第5の実施抵抗の実施例について説明する。

市販の平均粒経約1μmのBi2O3、PbO、Sb2Oa、SrCO。、CaCO。、CuOの各別末(純度99.9~99.99%)を、表5に示した組成割合で混合し、800℃で12時間の仮旋、粉砕、800℃で18時間の焼結、粉砕の各工程を経て、外径12mm、内径8mmの銀パイプに光楽し、直径2mmになるまで仲級した。これらの線材を、さらに、さらに厚さO。4mmのテーブ状となるように、冷即圧延し、840℃で50時間の無処理を行なった後、厚さO。25mmのテーブとするように冷彻圧延し、さらに8

•	o Z	4 1 回回 8 多齿炎中	現	磁界電流密度 (A / cm² , 17.8%)
¥	V - 1	845C×10A	なし	1320
*	V- 2	845C×30A	なし	1450
至	V~ 3	845℃×5時間	少ない	1650
	V- 4	845℃×10時間	少ない	3230
*	V- 5	845℃×20時間	#950%	7640
ev.	V- 6	845℃×50時間	100%	16600
=	V - 7	845℃×100時間	100%	17200
- E	V-8	845℃×200時間	100%	16800

40℃で50時間の熱処理を施した。これら840℃での2回の熱処理において300℃までの冷却建度を表5に示すように制御した。表5には、このようにして得られた線材の77、3Kでの臨界電流密度が示されている。

(以下全台)

_	H	ا	_	Ц.	<u>↓</u>	ار ا	5				ш	ш	#	<u>₩</u>	Ł
Ko.	-	2	٣	4	2	9	7	8	9	10	11	12	13	14	
-	1.8	1.8	1.1	1.8	1.8	1.1	1.9	1.8	1'1	1.1	9.	1.6	1.1	1.8	
Pb	9.0	9.6	7.0	9.4	1.0	1.0	0.4	0.4	9.0	0.4	0.4	1.0	9.0	1.4	
Sb	-		1.1	~	-	-	-	-	0.1	0.06	-	1		ı	
S	7	~	~	~	~	~	~	*	1	1	-	•	*	7	
S	1.1	1.0	1.1	1.1	7.	2.9	1.1	2.2	8.8	2.2	1.1	2.2	1.1	2.0	
Сu	S	8	8	-	-	\$	8	8	8	1	î	f		8	İ
冷却強度(C/B)	180	180	081	061	082	003	091	170	981	180	100	013	99	0)	
「MANA MANA MANA MANA MANA MANA MANA MANA	12.400	10.800	11.000	18.900	14.400	14.800	18.800	12.400	11.700	11.900	8.100	9.800	1.200	4.100	

M

特開平3-138820 (14)

以下、この発明に従う第6の実施態様の実施例 について説明する。

爽施例Ⅵ

Big O, 、PbO、SrCO。、CaCO。、CuOを用いて、Bi: Pb: Sr: Ca: Cu-1. 8: 0. 4: 2: 2. 2: 3の組成比の粉末を準備した。

この粉末を、表6に示す「焼結条件」で焼結した。この焼結は、炎6中の「No.1」、「No.2」、「No.3」の駆序で実施した。なお、「No.1」および「No.2」の焼結条件は、8~12時間であり、「No.3」については、12~24時間とした。また、「No.1」および「No.2」の焼結は大気圧下で行ない、「No.3」の焼粘は、表6中の括弧内に記入した圧力の大気中で実施した。

次に、表6に示した「競結条件」で焼結された 各試料を、内径4mm、外径6mmの銀パイプに 充塡した後、まず、これを直径1mmにまで仲稼 し、次いで、厚さり、5mmになるように圧延し た。続いて、各試料を、845でで50時間、熱 処理した後、冷間圧延を加えて、経々の厚みになるように加工した後、840℃で50時期の熱処理を施した。

得られた各試料を、被体整素に浸漉して、臨界電流密度を測定した。このとき、試料となる線材の長さを50cmとし、10cmごとの臨界電流出度のばらつきも調査した。これらの結果も、よ6に示されている。

(以下余日)

					-	
Ξ ::		税税条件		最終限分	一世紀紀紀紀日	西野は流気を
0 2	No. 1	No. 2	No. 3	(mm)	(A / Ca?)	のばらっき
	7500	8000	7600	0.45	8060	#3%
٠	,		(1 Torr)			
,	740°C	8100	770C	0.40	7640	# 2%
٧			(1 Torr)			
,	7500	8100	2091	0.43	8630	¥2%
n			(1 Torr)			
,	7500	7902	2011	0.48	9010	± 2%
₹			(1 Torr)			
4	740°C	8000	209L	0.39	7550	± 2%
<u> </u>			(i forr)	•		
,	740C	840C	8100	0.45	8470	± 2%
0			(1 Torr)			
,	7505	820E	2062	0.43	8290	#3%
		•	(I forr)			
۵	2057		288C	0.42	3230	± 5%
,			(1 Torr)			
6	760t	8400	_	0.43	3490	±44%

表6から明らかなように、この第6の実施参様に従えば、臨界電流密度が高く、かつ長さ方向にわたってそのような臨界電流密度がほとんどばらつかない酸化物超電率線材が得られている。なお、といれて、 は料 No. Wi - 9 が範囲外である。ここで、は料 No. Wi - 8 とは料 No. Wi - 9 とを比較したとき、この第6の実施整縁の範囲外である。ここで、は科 No. Wi - 8 とは料 No. Wi - 9 とを比較したとき、この第6の実施整縁の範囲外にあるは料 No. Wi - 9 の方が、範囲内にあるは 科 No. Wi - 9 の方が、 範囲内にあるは 科 No. Wi - 9 の方が、 である。 は料 No. Wi - 9 は、「 ± 4 4 % 」という極めて高い 臨界電流密度のばらつきを示している。

实施例证

以下、この免明において好ましい実施競技とされている企属シースの使用についての実施例を示す。

Bi: Pb: Sr: Ca: Cu=0. 8:0. 2:1:1:2の制合となるように、混合された

9

特閒平3-138820 (15)

それぞれの酸化物物末を、800℃で2回、860℃で1回仮焼結した。次に、この仮焼結した砂 末を、被重部材である銀からなる金属シース中に 充塡し、引抜き加工、スエージ加工およびプレス 加工して、0.3mmの直径のワイヤとした。

この似で被覆されたワイヤを、845でで無処理時間を変えて熱処理し、内部を酸化物超電導体組成とした。それぞれの熱処理後のワイヤから銀シースを剥ぎ取り、帯磁率を測定することによって、酸化物超電導体内での高温超電導相の体験割合 V m T c / V m T c : 高温超電導相の体験: V m c : 超電導相の全体数)を求めた。得られた結果を第4因に示す。

また、比較のため、上述の実施例と同様に800でで2回、860でで1回仮焼結を実施した粉束をプレス成形し、この成形体を860でで時間を変えて熱処理し、酸化物超電導体組成とした後、同様に帯磁率を測定し高温超電導相の体積制合を求めた(比較例)。第4図に併せて測定結果を示す。なお、この比較において熱処理温度を860

得られた酸化物超電導体では、従来のようなショルダが現れれず、ほぼ高温超電導相のみであり、 単一相化していることがわかる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、この発明の製造方法を示すフローチ ャート図である。

第2図は、実施例皿において高い臨界電流出放 を示した超電導体の超電導相および非超電導相の 状態を示す模式図である。

第3図は、実施例皿において比較的低い臨界電 液密度を示した超電導体における超電導相および 非超電導相の状態を示す機式図である。

第4回は、実施例確における熱処理時間と高温 超階等相の外積割合との関係を示す数である。

第5回は、実施例でで得られた酸化物部電導体の番組率と温度との関係を示す図である。

特許出版人 住女電気工業株式会社 代 理 人 弁理士 葆 見 久 郎 (ほか2名)

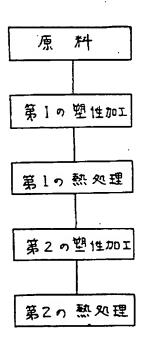


でとしているのは、このようにしてプレス成形された成形体が、845ででは酸化物型電導体組成にならないからである。

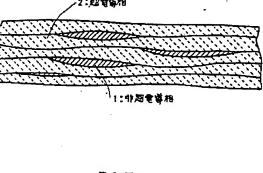
第4図から明らかなように、銀シースで被重し 熱処理したものは、ほぼ10時間で高温超電専相 のみの単一相となった。これに対し、被複部材で 凝わずに熱処理した比較例のものは、200時間 熱処理しても単一相にならなかった。

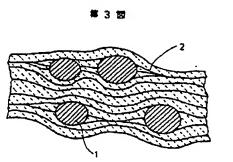
上記の実施例の方法で24時間熱処理したものについて、銀シースを初いで液体緊挛中(77.3K)で4端子法により、臨界電流密度を測定したところ、1850A/cm²の値が得られた。また、電気抵抗の測定により、電気抵抗が減少し始める温度、すなわちTcongtは110Kであり、完全に電気抵抗が0になる温度は104Kであった。第5図には、このものについての事磁準と温度との関係を実験で示す。また、第5図には、従来の製造方法により製造されたBi-Pb-Sr-Ca-Cu系数化物超電導体の結果を点線で示す。第5図で示されるように、この実施例により

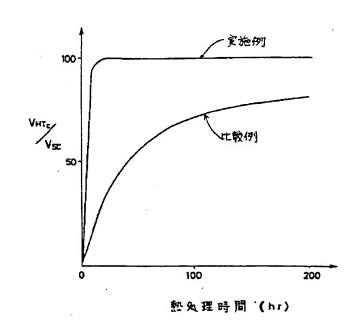
第 1 图

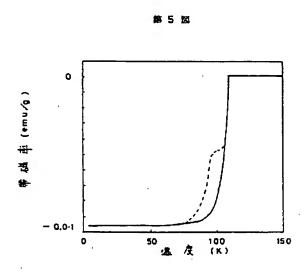


特閒平3-138820 (16)









第1頁の続き

⑩Int.CL. \$ 識別記号 庁内整理番号

H 01 B 12/04 ZAA 8936-5G

優先権主張 @昭63(1988)9月17日國日本(JP) @特願 昭63-233084

❷昭63(1988)12月28日❷日本(JP)動特顯 昭63-334576

型平1(1989)1月27日回日本(JP)回特顯 平1-18664

劉平1(1989)2月6日國日本(JP)到特顯 平1-28117

〒1(1989)3月16日3日本(JP)3時題 平1-65695

❷平1(1989)6月24日❷日本(JP)動特願 平1-162442

級平1(1989)6月27日級日本(JP) 図特題 平1-164510

@発 明 者 大 松 一 也 大阪府大阪市此花区島屋1丁目1番3号 住友電気工業株式会社大阪製作所内

⑫発 明 者 永 田 正 之 大阪府大阪市此花区島屋1丁目1番3号 住友電気工業株

式会社大阪製作所内

@発明者高野悟大阪府大阪市此花区島屋1丁目1番3号住友電気工業株

式会社大阪製作所内

⑫発 明 者 細 田 義 門 大阪府大阪市此花区島屋1丁目1番3号 住友電気工業株

式会社大阪製作所内

@発 明 者 一 柳 擎 大阪府大阪市此花区島屋1丁目1番3号 住友電気工業株

式会社大阪製作所内

@発 明 者 川 島 質 生 大阪府大阪市此花区島屋1丁目1番3号 住友電気工業株

式会社大阪製作所内

@ 発明 者 渋田 信 廣 大阪府大阪市此花区島屋1丁目1番3号 住友電気工業株

式会社大阪製作所内

手統施正告

平成1年9月14日

適

特許厅長官城

1、事件の表示

平成1年特許順定 209325 号

2、発明の名称

酸化物館電導体の製造方法

3、補正をする者

事件との関係 特許出題人

住 所 大阪市中央区北浜四丁目5番33号

名 称 (213) 住友電気工業株式会社

代表者 川上哲郎

4、代理人

住 所 大阪市共区南森町2丁目1番29号 住友銀行南森町ビル

地話 大阪 (06) 361-2021 (代)

氏名 弁理士(6474) 深見久郎



5、拡正命令の口付

自念城正



2. 特許請求の範囲

(1) 原料を熱処理することによりBi-Pb-Sr-Ca-Cu系酸化物超電導体を製造する方法であって、

前記原料に第1の塑性加工を施し、

前記第1の要性加工を施した材料に第1の熱処型を施し、

第記第1の熱処理を施した材料に第2の塑性加工を施し、

前記第2の塑性加工を超した材料に第2の熱処理を駆す各ステップを輸える、酸化物型電源体の製造方法。

- (2) 耐記第1の製性加工のステップが、金 メシースに変換された原料に対して第1の製性加工を施すステップを雇える、請求項1記載の設化 物類電導体の観波方法。

6. 補正の対象

明細書の特許請求の範囲の個および発明の詳細な説明の翻

7. 補正の内容

- (1) 明細密の特許請求の範囲を別紙のとおり私正する。
- (2) 明綱書第19頁第20行の [e:=] を「e-」に補正する。
- (3) 明報書第24頁第11行の「e:-j を「e-」に補正する。

以上

(4) 前記Bi-Pb-Sr-Ca-Cu系 酸化物超電導体が、

Bi zi = xP bx Sr zz Ca z. Cuy

(ここで、x, y, z₁, z₂およびz₄は、 0. 2≤x≤0. 8, 1. 5≤z₁, z₂, z₃ ≤3: 0, 2. 5≤y≤4, 5を試足する数であ

と酸素からなる組成を有する、請求項 1 記載の酸 化物超電導体の製造方法。

(5) 前記BiーPbーSrーCaーCu系 酸化物超電器体が、

Bia Pb b Src Cad Cue

(ここで、a, b, c, dおよびeは、a+b:
c:d:e=1.7~2.8:1.7~2.5:
1.7~2.8:3を満足する数である。)
と酸素からなる組成を有する、効求項1記載の酸
化物組電導体の製造方法。

(6) 原料を無処型することによりBi-Pb-Sr-Ca-Cu系酸化物超電導体を製造する方法であって、

前記原料に第1の塑性加工を施し、

前記第1の塑性加工を施した材料に780~8

60℃の温度範囲内で第1の熱処理を施し、・

前記第1の熱処理を施した材料に斯面減少単が

10%以上の第2の塑性加工を施し、

頭記第2の塑性加工を施した材料に780~860での温度範囲内で第2の熱処理を施す各ステップを縮える、酸化物超電導体の製造方法。

- (7) 前紀第1の製性加工のステップが、全 減シースに充填された原料に対して第1の製性加 工を施すステップを行える、助求項6記載の数化 物型電券体の製造方法。
- (8) 耐配金属シースが果または銀合金からなる、請求項7記載の酸化物超電導体の製造方法。
- (9) 前記型性加工が、圧延加工、プレス加工または仲線加工である、結束項6に記載の酸化物組電導体の製造力法。
- (10) 前記Bi-Pb-Sェ-Ca-Cu 系数化物超電導体が、

Bi2-1 Pbx SrZ Ca2 Cuy

らなる、緯水項12記載の酸化物超電導体の製造 方法。

- (14) 前記要性加工が、圧延加工、プレス 加工または仲線加工である、請求項11に記載の 酸化物超電導体の製造方法。
- (15) 前記Bi-Pb-Sr-Ca-Cu 系数化物超電導体が、

Bi z₁-xPbx Sr z₂ Ca z₄ Cuy

(ここで、x, y, z,, z, およびz, は、 0、2≤x≤0、8, 1、5≤z,, z, z, ≤3、0, 2、5≤y≤4、5を銭足する数である。)

と酸素からなる組成を有する、請求項11記載の 酸化物超電導体の製造方法。

(16) Big Pb, Src Cag Cue (ここで、a, b, c, dおよびeは各元素の組成比を示す数である。) および酸素からなる組成を有する超電導体であって、

斯記a. b. c. d. およびeが、

 $a+b:c:d:e=1.7\sim2.8:1.7$

(ここで、xおよびyは、0.2≤x≤0.8.2.5≤y≤4.5を誤足する数である。) と酸素からなる組成を行する、請求項6記載の酸化物胚指導体の製造方法。

(11) 原料を熱処理することによりBi-Pb-Sr-Ca-Cu系数化物組電導体を製造する方法であって、

前記原料に第1の製性加工を施し、

前記第1の塑性加工を施した材料に780~860での温度範囲内で第1の熱処理を施し、

前記第1の無処理を築した材料にlton/cm²以上の借价を加える第2の製性加工を施し、

前記第2の塑性加工を凝した材料に780~860での温度範囲内で第2の無処理を施す各ステップを備える、競化物超電導体の製造方法。

- (12) 前記第1の型性加工のステップが、 全国シースに充填された原料に対して第1の型性 加工を施すステップを値える、請求項11に記載 の酸化物超端事体の製造方法。
 - (13) 順記金属シースが載または観合金か

~2. 5:2. 0~2. 5:3、および

 $a:b-3\sim9:1$

を講足し、かつ配向した超電専相の粒界部に非超 電専相が分散して存在していることを特徴とする、 超電磁体。

(17) 原料を熱処理することによりBi-Pb-Sr-Ca-Cu系数化物超電導体を製造する方法であって、

前記原料として低い臨界型皮の超電導相が主に 生成されるように熱処理された粉末を準備し、

前記原料に第1の塑性加工を施し、

前記第1の親性加工を施した材料に第1の熱処 鍵を施し、

前記第1の無処理を施した材料に第2の塑性加工を施し、

前記第2の塑性加工を施した材料に第2の熱処理を施す各ステップを鍛える、酸化物超電弱体の製造方法。

(18) 前記第1の数性加工のステップが、 全国シースに充集された原料に対して第1の数性

特閒平3-136820 (20)

加工を施すステップを崩える、請求項17に記載の酸化物超越導体の製造方法。

- (19) 頼紀全国シースが、観または銀合金からなる、請求項18に記載の酸化物組定導体の製造方法。
- (20) 原料を熱処理することによりBi-Pb-Sr-Ca-Cu系酸化物紅電母体を観過する方法であって、

前記原料に第1の製性加工を施し、

前記第1の塑性加工を施した材料に第1の熱処 理を施して高い腐界温度の超電導相を生成させ、

南記第1の無処理を能した材料に第2の製性加工を施し、

前記第2の類性加工を施した材料に第2の熱処理を施す各ステップを備える、酸化物超電導体の製造方法。

(21) 前記第1の塑性加工のステップが、 金属シースに支払された原料に対して第1の型性 加工を施すステップを備える、結束項20に記載 の酸化物超電導体の製造方法。

理を凝し、

前配第1の熱処理を施した材料を少なくとも3 00でまでの程度範囲において100℃/特以上 の速度で冷却し、

府記第1の熱処理後冷却した材料に第2の観性 加工を施し、

前記第2の塑性加工を超した材料に第2の熱処理を施し、

前記第2の無処理を施した材料を少なくとも300でまでの温度範囲において100℃/時以上の速度で冷却する各ステップを備える、硬化物超電導体の製造方法。

- (26) 前記第1の熱処理および第2の無処理がそれぞれ800~860℃の温度で熱処理をれる、請求項25に記載の使化物超電導体の製造方法。
- (27) 前記第1の熱処理および第2の熱処理後の冷却が、それぞれ500で程度までの温度: 範囲で150℃/時以上の速度で冷却される、請求項25に記載の彼化物超電視体の製造方法。

(22) 前記Bi-Pb-Sr-Ca-Cu 系数化物超電路体が、

Bia Pbo Src Cad Cue

(ここで、a, b, c, dおよびeは、a+b:
c:d:e-1.7~2.8:1.7~2.5:
1.7~2.8:3を認见する数である。)
と 機楽からなる組成を育する、類次項20記載の
酸化物超電導体の製造方法。

- (23) 顔記金属シースが、酸化物超電導体 と反応せず、かつ低比低抗の金属または合金から なる、額求項21に記載の酸化物超電導体の製造 方法。
- (24) 前記金銭シースが、領または銀合金である、請求項21に記載の数化物超電導体の製造方法。
- (25) 原料を熱処理することによりBi--Pb-Sr-Ca-Cu系酸化物超電器体を製造する方法であって、

前記原料に第1の塑性加工を施し、 前記第1の製性加工を超した材料に第1の熱熱

- (28) 前記第1の無処理および第2の無処理後の冷却が、それぞれ強制的に行なわれる。 第次項25に記載の酸化物超電導体の製造方法。
- (29) 前記Bi-Pb-Sr-Ca-Cu 系酸化物超電導体がアンチモンを含む、請求項2 5に記載の酸化物超電導体の製造方法。
- (30) 副記第1の型性加工のステップが、 金属シースに充填された級料に対して第1の型性 加工を施すステップを備える、結束項25に記載 の酸化物超電導体の製造方法。
- (31) 原料を熱処理することにより、Bi
 -Pb-Sr-Ca-Cu系酸化物超磁感体を製造する方法であって、

前記原料として、減圧雰囲気下で焼結した粉末 を準備し、

前配原料に第1の塑性加工を施し、

前記第1の塑性加工を施した材料に第1の熱処理を施し、

旗記第1の熱処理を施した材料に第2の整性加工を施し、

特別平3-138820 (21)

前記第2の理性加工を施した材料に第2の熱処理を施す各ステップを備える、酸化物超電導体の型量方法。

- (32) 前記第1の塑性加工のステップが、 金属シースに充填された原料に対して第1の塑性 加工を施すステップを備える、請求項31に記載 の酸化物組電導体の製造方法。
- (33) 前記Bl-Pb-Sr-Ca-Cu系酸化物級電車体が、

Big Pbb Src Cad Cue

(ここで、a, b, c, dおよびeは、a+b:
c:d:e=1.7~2.8:1.7~2.5:
1.7~2.8:3を誤足する数である。)
と改染からなる組成を行する、請求項31に記載
の酸化物経電導体の製造方法。

- (34) 前記金属シースが酸化物超電導体と 反応せず、かつ低比抵抗の金属または合金からなる、請求項32に記載の酸化物超電導体の製造方法。
 - (35) 前記金属シースが、銀または銀合金

前記会民シースに充塡した原料に第1の製性加工を施し、

南記第1の製作加工を超した材料に780~860での温度範囲内で第1の熱処理を施して高い 臨界温度の組織専相を生成させ、

前記第1の熱処型を施した材料を少なくとも300でまでの製度範囲において100で/時以上の速度で冷却し、

前記第1の熱処理後冷却した材料に1 ton/cm²以上の荷重を加える第2の製性加工を能し、前記第2の製性加工を能した材料に第2の熱処理を能し、

前記第2の熱処理を返した材料を少なくとも3 00でまでの置度範囲において100で/時以上 の速度で冷却する各ステップを備える、数化物超 電源体の製造方法。

(40) 原料を熱処理することによりBi-Pb-Sr-Ca-Cu系数化物超電導体を製造する方法であって、

前記原料を前記録化物組朮導体と反応しにくい

からなる、雪求項32に記載の酸化物超電場体の 製造方法。

- (36) 南記越圧雰囲気がおよそ1 T.o.r.r に越圧した火気の雰囲気である、結束項3 1 に記 級の酸化物組制導体の製造方法。
- (37) 前記録正容明気下の挽結型皮が72 0~850でである、請求項31に記載の酸化物 組朮将体の製造方法。
- (38) 前記減圧労団気下での使結に失立って、減圧労団気下での使結温度より低い程度で焼結され、次いで減圧労団気下での温度より高い温度で焼結される。「請求項31に記象の酸化物超電場体の製造方法。
- (39) 原料を熱処理することによりBi-Pb-Sr-Ca-Cu系酸化物超電導体を製造する方法であって、

前記原料として、減圧券四気下で英枯して低い 臨界温度の超電事相を主に生成させた粉末を準備

1...

南記原料を金属シースに充単し、

金属材料からなるシースに充堪し、前紀金属シースに充堪された原料に前記熱処理を施す各ステップを備える、酸化物超電導体の製造方法。

(41) 前記金属シースが製または銀合金からなる、結束項40記載の鉄化物超電等体の製造方法。

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.